Bi:YIG/Pt におけるスピンゼーベック効果の保持力の温度差依存性

髙橋優太、高瀬つぎ子、山口克彦 (福島大)

Temperature difference dependence of coercive force of spin Seebeck effect in Bi:YIG/Pt Y. Takahashi, T. Takase, K. Yamaguchi

(Fukushima Univ.)

はじめに

強磁性体と常磁性金属の接合系に温度差があるとき、その接合界面近傍にスピン流が誘起される現象とし て「スピンゼーベック効果(以下 SSE)」がある. 誘起されたスピン流は常磁性金属を介し, 温度差に比例した 電圧に変換される ^り. この機構により生成された電圧(以下 SSE 電圧)の温度差依存性は, 様々な材料において 報告がなされている.しかし, SSE 電圧の保持力に着目した報告は少なく, その温度依存性について系統的 に調査された報告はない.本研究では、Bi:YIG/Pt 試料における SSE 電圧の保持力の温度差依存性について、 系統的に調査した結果を報告する.

実験・結果

有機金属分解法を用いて、厚さ 0.45mm の石英ガラス基板上に多結晶 Bi:YIG 膜を製膜した後、簡易スパッ 夕装置(Ar・10Pa)により Pt 膜を 10nm 積層した.さらに,試料全体を大気圧下で 600℃・1hour の熱処理を施 した Bi:YIG/Pt 試料 ²⁾を用いる.

Fig.1 に各温度差における SSE 電圧と磁場のヒステリシス曲線の測定結果を示す. Fig.1 の測定に用いた試 料の面積は 7mm×13mm, Bi:YIG 膜の膜厚は約 400nm である. Fig.1 より SSE 電圧がゼロとなる時の外部磁 場(以下 SSE 電圧の保持力)が温度差によって変化していることが確認された. さらに,同じ面積, Bi:YIG 膜 の膜厚が約 200nm の試料においても同様の現象が確認された.また, Fig.2 に SSE 電圧の保持力の温度差依 存性を示す.加えて,外部磁場がゼロとなる時の SSE 電圧(以下残留 SSE 電圧)も示す.それぞれ, Fig.1 以外 の温度差も含め、外部磁場を+から-、-から+に印加したときの絶対値を平均した値で示す. Fig.2 より残 留 SSE 電圧は既知の通り温度差に比例したが、SSE 電圧の保持力は従来とは異なり、ΔT=15K 付近を境に急 激に変化していることが確認された.この SSE 電圧の保持力の変化の要因について,試料の面積や Bi:YIG 膜の膜厚を変化させ、系統的に SSE 電圧の保持力の温度依存性を示し、その関連性を検討する.



ਚ 600 120 0^e0 Coercive force of VRemanence of V 500 Coercive force of ${\cal V}_{SSE}$ 400 SSE 80 ы. 300 60 anence 200 40 Bem 100 R 200 £0 2530 $\mathbf{5}$ 101520 0 Temperature difference ΔT (K)

Fig.1 Hysteresis curve of voltage of spin Seebeck effect Fig.2 Temperature difference dependence of and magnetic field at each temperature difference

coercive force of V_{SSE} and remanence of V_{SSE}

参考文献

1) K. Uchida, H. Adachi, T. Ota, H. Nakayama, S. Maekawa, and E. Saitoh: Appl. Phys. Lett., 97, 172505 (2010). 2) Y. Takahashi, T. Takase, and K. Yamaguchi: T. Magn. Soc. Jpn. (Special Issues)., 4, 14-17(2020).